

تمرین سری اول شبیه سازی

مدار یک طبقه CB ای با مشخصات زیر طراحی کنید.

مشخصات ترانزیستور: 
$$eta=100$$
 ,  $V_A=100$  ,  $I_S=1f$ 

جريان باياس شده: Ic = 1mA

$$DC$$
 مشخصات منبع:  $Vcc=10V$  ,  $V_{\it EE}=0$ 

$$AC$$
 مشخصات منبع:  $R_{S} = 50\Omega$ 

مشخصات تقویت کننده: Av>20 ,  $R_i>150\Omega$  ,  $R_{out}<4.5k\Omega$  ,  $swing>8^{V}{}_{p-p}$  , THD<5%

تنها كد HSPICE مدار طراحى شده براى تحليل tran. وac. (جمعا دو فايل با پسوند sp.) را ارسال فرماييد. موفق باشيد